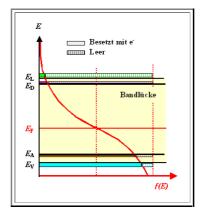
Quantitative Berechnung der Fermienergie bei dotierten Halbleitern

Wo liegt die Fermienenergie ?

- Wir lassen beliebige Konzentrationen an Akzeptoren und Donatoren zu; betrachten aber nur zwei zusätzliche Niveaus in der Bandlücke bei ED und EA
 - Die zugehörigen Zustandsdichten sind identisch mit den Konzentrationen der Dotieratome, d.h. wir haben No und No Plätze für Elektronen bei den zugehörigen Energien.
 - Wir zeichnen das alles einfach mal in ein Banddiagramm und schauen uns an, wieviele der angebotenen Plätze besetzt sind bei einer Fermiverteilung mit zunächst noch willkürlich gewählter Fermienergie. Das ist jetzt einfach zu machen und schaut so aus:



Die farbigen Balken symbolisieren (von oben nach unten) die Zustandsdichten

N _{eff}	^L bei	EL	
N _D	bei	E D	
NA	bei	E _A	
Neff	V bei	E _V	

- Was wir *jetzt* zu beachten haben, um die Fermienergie bestimmen zu können, ist **Elektroneutralität** nur mit der Gleichsetzung zweier Konzentrationen wie bisher kommt man nicht weiter.
 - Was für Ladungen haben wir zu beachten? Wo hat sich etwas geändert (immer im Vergleich zu T = 0K)?
 - Schauen wir uns also die Bilanz an, getrennt nach negativen und positiven Ladungen. Wir schreiben das Ganze in fast voller Allgemeinheit mit der Fermiverteilung für die Dotierniveaus, und den effektiven Zustandsdichten und der Boltzmann-Näherung für die Bänder um die unhandliche Integrale zu vermeiden.

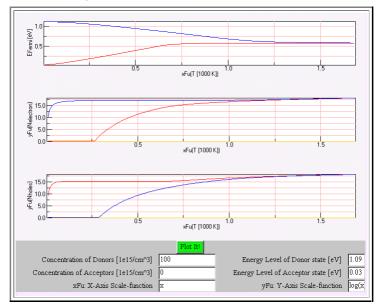
Negativ		Positiv		
Art	Formel	Art	Formel	
Elektronen in L	$n_{L} = N_{\text{eff}}^{L} \cdot \exp(E_{L} - E_{F})/kT$	Löcher in V	$n_{V} = N_{\text{eff}}^{V} \cdot \exp{-(E_{F} - E_{V})/kT}$	
negativ ionisierte Akzeptoren	$N^-A = N_A^L \cdot f(E_A, E_F, T)$	positiv ionisierte Donatoren	$N^{+}_{D} = N_{D} \cdot \{1 - f(E_{D}, E_{F}, T)\}$	

 Alles was wir nun zu tun haben, ist Ladungsneutralität in der Form Σ neg. Ladungen = Σ pos. Ladungen aufzuschreiben, d.h. folgende Gleichung:

$$N_{\text{eff}}^{\text{L}} \cdot \exp(E_{\text{L}} - E_{\text{F}})/kT + N_{\text{A}} \cdot f(E_{\text{A}}, E_{\text{F}}, T) = N_{\text{eff}}^{\text{V}} \cdot \{1 - f(E_{\text{V}}, E_{\text{F}}, T_{\text{V}})\} + N_{\text{D}} \cdot \exp(E_{\text{F}} - E_{\text{V}})/kT$$

- Voilá eine Gleichung für die eine Unbekannte E_F das hatten wir schon mal. Wir müssen nur nach E_F auflösen fertig!
 - Ob man diese Gleichung wohl analytisch lösen kann? Nun vergiß es!

- Es geht nicht; und wir müssen nun zu Fallunterscheidungen und Näherungen Zuflucht nehmen oder zum PC, den wir ja zur Betrachtung dieses Hyperskripts schon haben.
- Denn die *numerische* Lösung der obigen Gleichung für beliebige Parameter ist kein großes Problem; wir können die Fermienergie jetzt also *immer* ausrechnen.
 - Und wenn wir die Fermienergie haben, k\u00f6nnen wir sie benutzen um (ebenfalls numerisch) alle gew\u00fcnschten Konzentrationen als Funktion aller vorgegebenen Parameter auszurechnen.
 - Das tun wir mal in einem eigenen Modul mit einem entsprechenden JAVA Applet, das die Numerik für uns übernimmt. Was man erhält sieht beispielsweise so aus:



- Gezeigt ist:
 - Die Fermienergie als Funktion der Temperatur (obere Kurve)
 - Der log der Konzentration von Elektronen im Leitungsband als Funktion der Temperatur (mittlere Kurve).
 - Der log der *Konzentration von Löchern* im Valenzband als Funktion der Temperatur (untere Kurve) für eine Konzentration an Akzeptoren von **10**¹⁵ **cm** ⁻³ mit den roten Linien, und für eine Konzentration an Donatoren von **10**¹⁷ **cm** ⁻³ mit den blauen Linien.
- Eigentlich ist damit alles gesagt. Da wir uns aber für *prinzipielle* Betrachtungen mit analytischen Formeln viel leichter tun als mit der Numerik, wird sich das nächste Unterkapitel mit einigen sehr nützlichen analytischen Formeln für die Ladungsträgerkonzentrationen beschäftigen.